

Ба 199304

Минский научно-исследовательский
приборостроительный институт

Минский радиотехнический институт

Белорусское республиканское правление
НТО радиотехники, электроники и связи им. А.С.Попова

Белорусское республиканское правление
НТО машиностроительной промышленности

Белорусский научно-исследовательский институт научно-
технической информации и технико-экономических исследований
Госплана БССР

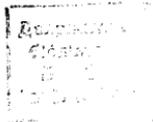
Минский Дом техники

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Тезисы докладов научно-технической конференции

Минск, 27-28 февраля 1985 г.

Минск 1985



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ БИС ЗУ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕРАБОТОСПОСОБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАМЯТИ

Основным источником информации о количественных характеристиках дефектов элементов памяти (ЭП) в БИС ЗУ является обработка экспериментально полученных статистических данных. Отсутствие экспериментальных данных может привести к необоснованному увеличению объема аппаратных затрат с целью нейтрализации определенного количества дефектов ЭП в БИС ЗУ.

В докладе приводятся результаты распределения дефектов в БИС ЗУ емкостью 4 Кбит. Анализ результатов показал, что:

большинство дефектов являются единичными, т.е. неработоспособным оказывается один ЭП;

характеристики распределения дефектов по строкам и по столбцам накопителя примерно одинаковы;

характер распределения дефектов по кристаллу не всегда бывает статистически независимым, с увеличением степени интеграции и размеров кристаллов БИС приобретает все большее значение учет неравномерности распределения дефектов, т.е. их группирования.

Приводятся количественные характеристики распределения дефектов, учет которых поможет выбрать оптимальный метод создания устройств памяти, не чувствительных к определенному количеству неисправностей ЭП.

УДК 621.315

И.И.ДОЛЬ, В.В.КОРОТКЕВИЧ,
А.А.ЛИС, В.И.УТЕНКО

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУИЗОБИРУЮЩЕГО АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Современная полупроводниковая технология освоила производство приборов СВЧ- и оптического диапазона на основе соединений A^3B^5 . При формировании структур, использующих в ка-